

Type No.	V _{CEs} (V)	I _c (A)	V _{CE(sat)} MAX.		SW TIME (MAX.)			Circuit Symbol	Package Style
			(V)	I _c (A)	ton (μs)	toff (μs)	tf (μs)		
MG25Q2YS9	1200	±25×2	4	25	0.8	1.5	0.5	YS	32
MG25Q6ES1	1200	±25×6	4	25	0.8	1.5	0.5	ES	23
MG50Q2YS9	1200	±50×2	4	50	0.8	1.5	0.5	YS	32
MG50Q6ES1	1200	±50×6	4	50	0.8	1.5	0.5	ES	23
MG75Q2YS1	1200	±75×2	4	75	0.8	1.5	0.5	YS	26
MG100Q2YS1	1200	±100×2	4	100	0.8	1.5	0.5	YS	22
MG150Q2YS1	1200	±150×2	4	150	0.8	1.5	0.5	YS	22
MG200Q1US1	1200	±200	4	200	0.8	1.5	0.5	US	21
MG200Q2YS1	1200	±200×2	4	200	0.8	1.5	0.5	YS	22
MG300Q1US1	1200	±300	4	300	0.8	1.5	0.5	US	21
MG300Q1US2	1200	±300	4	300	0.8	1.5	0.5	US	21
MG400Q1US1	1200	±400	4	400	0.8	1.5	0.5	US	21
MG400Q1US2	1200	±400	4	400	0.8	1.5	0.5	US	21

e) IGBT TYPE (LOW SATURATION TYPE)

Type No.	V _{CEs} (V)	I _c (A)	V _{CE(sat)} MAX.		SW TIME (MAX.)			Circuit Symbol	Package Style
			(V)	I _c (A)	ton (μs)	toff (μs)	tf (μs)		
MG25J2YS91	600	±25×2	2.7	25	0.8	1.6	1.0	YS	32
MG50J2YS91	600	±50×2	2.7	50	0.8	1.6	1.0	YS	32
MG50J6ES11	600	±50×6	2.7	50	0.8	1.6	1.0	ES	14
MG75J2YS91	600	±75×2	2.7	75	0.8	1.6	1.0	YS	32
MG75J6ES11	600	±75×6	2.7	75	1.0	1.6	1.0	ES	14
MG100J2YS91	600	±100×2	2.7	100	0.8	1.6	1.0	YS	32
MG100J6ES11	600	±100×6	2.7	100	0.8	1.6	1.0	ES	14
MG100J6ES91	600	±100×6	2.7	100	0.8	1.6	1.0	ES	31
MG150J2YS11	600	±150×2	2.7	150	0.8	1.6	1.0	YS	24
MG200J2YS11	600	±200×2	2.7	200	0.8	1.6	1.0	YS	24
MG300J2YS11	600	±300×2	2.7	300	0.8	1.6	1.0	YS	22
MG400J1US11	600	±400	2.7	400	0.8	1.6	1.0	US	21
MG400J1US21	600	±400	2.7	400	0.8	1.6	1.0	US	21
MG50Q2YS91	1200	±50×2	2.7	50	0.8	1.8	1.0	YS	32
MG50Q6ES11	1200	±50×6	2.7	50	0.8	1.8	1.0	ES	23
MG75Q2YS11	1200	±75×2	2.7	75	0.8	1.8	1.0	YS	26
MG100Q2YS11	1200	±100×2	2.7	100	0.8	1.8	1.0	YS	22
MG150L2YS11	1200	±150×2	2.7	150	0.8	1.8	1.0	YS	22
MG200Q2YS11	1200	±200×2	2.7	200	0.8	1.8	1.0	YS	22
MG300Q1US11	1200	±300	2.7	300	0.8	1.8	1.0	US	21
MG300Q1US21	1200	±300	2.7	300	0.8	1.8	1.0	US	21
MG400Q1US11	1200	±400	2.7	400	0.8	1.8	1.0	US	21
MG400Q1US21	1200	±400	2.7	400	0.8	1.8	1.0	US	21